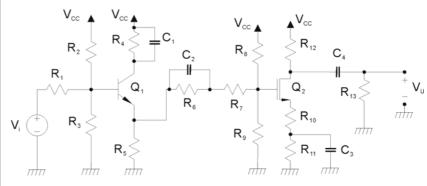
ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 30 giugno 2014

Esercizio A

$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{10} = 50 \ \Omega$
$R_3 = 500 \text{ k} \Omega$	$R_{11}=2950\;\Omega$
$R_4 = 1.5 \text{ k}\Omega$	$R_{12} = 4 \text{ k}\Omega$
$R_5 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{13} = 10 \text{ k}\Omega$
$R_6 = 950 \Omega$	$C_1 = C_2 = 1 \mu F$
$R_7 = 50 \Omega$	C ₃ = 100 nF
$R_8 = 18 \text{ k } \Omega$	$C_4=1 \text{ nF}$
$R_9 = 6 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$



 Q_1 è un transistore BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$. Q_2 è un transistore MOS a canale n resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con k = 0.5 mA/V² e $V_T = 1$ V. Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_2 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q_2 sia 10 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_2 . (R: $R_2 = 6646.66 \Omega$)
- 2) Determinare V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 e C_4 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -2.016$)
- 3) (<u>Solo per 12 CFU</u>) Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = f_{p1}$; $f_{z2} = 167.53$ Hz; $f_{p2} = 202.19$ Hz; $f_{z3} = 539.51$ Hz; $f_{p3} = 3433.23$ Hz; $f_{z4} = 0$ Hz; $f_{p4} = 11368.21$ Hz)

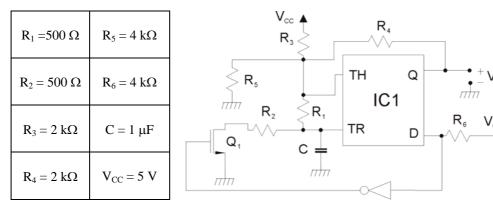
Esercizio B

Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \left(\overline{B} + \overline{C}\right)\left(\overline{A}\overline{B} + D + \overline{B}\overline{E}\right) + \overline{\overline{C}E}\left(\overline{A} + BD + \overline{E}\right) + A\overline{B}$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

Esercizio C



Il circuito IC_1 è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 5V$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e V_T =1 V_T =

RI= JOKR G R3 = 500K2 R4 = 1.5K2 R5 = 10KR R6 = 950R Rx = 502 ·) Det. Rz in made che Voz= 10V R8 = 18KR Rg = 6KR IL= VCC-16 = 18-10 = 2 mA = I10 R10 = 50 D Vs= In (RIO+RII) = 6V R11 = 2950 R Velle V65 = VT + V ID = 1+2 = 3V Rec = MKR K13 = 10KR V6 = V65+ V5 = 3+6 = 3 V Vcc= 18V Ig = VCC-VC = 18-9 = 0.5 mA Cs = Int (2 = 1 MF $\overline{1}_3 = \frac{V_6}{R_4} = \frac{3}{6000} = 1.5 \text{ mA}$ C3 = 100 nF Ch = InF I6 = Ig - I8 = 1 m A K= 0.5 x10-3 4 VE == @CREO (R6+R2) I6+V6 = 10V Is = VEL = 10 = 1 mA IE = Is+ Io = 2mA ~ Ic $T_{c} = 2mA$ $V_{c} = 5V$ $\begin{cases} \beta_{F} = 290 \text{ } \Rightarrow T_{g} = 6.836 \mu. \\ h_{i} = 4800 \text{ } \end{cases}$ Q_{d} $h_{f} = 300$ Vc = Vcc - Ra Ic = 18-3= 15V VCE = VC - VE = 15 - 10 = 5V VB = VE+ V8 = 10.2V I3 = VB = (0.7 = 21.4 pc A $I_1 = \frac{V_0}{R_1} = \frac{10.7}{10^4} = 1.07 \text{ mA}$ $I_2 = I_1 + I_3 + I_8 = 1.0983 \text{ mA} =$ $R_2 = \frac{V_{cc} - V_8}{I_2} = 6646,66 \text{ R}$

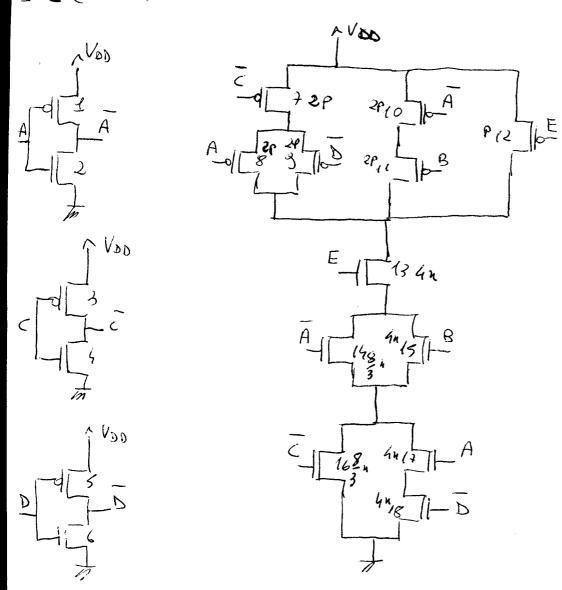
 $Q_{1} = \begin{cases} T_{c} = 2mA \\ V_{c} = 5V \\ T_{g} = 6.896 \mu A \\ hic = 4800 Jc$ 1 Pe = 300 $Q_{2} \begin{cases} T_{D} = 2mA \\ V_{DS} = 4V > (V_{65} - V_{7}) = 2V \\ V_{6S} = 3V \\ Q_{n} = 2K(V_{6S} - V_{7}) = 2 \times 10^{-3} \frac{A}{V} \end{cases}$ ·) (42(000 DI Aco Ve = - gm Jgs (RellR13) Vs= Riognidgs Vos = V6 - V5 = V6 1+(8 m Ric) Iq= (hpe+1) ib Rs+Rq+(RgllRg) Vo= (R8/1Rg) I7 = (R8/1Rg) (hPers) R5-R2+(Re/1Rg) 13 à puis sesore 9. Li Thereni. RV= {RS II[R++(RBIIRS)]} (hPe+1) 16= Usix = Ui RellRs (RILRS) (RILRS | RILRS |

$$=\overline{BC}(\overline{AB}+D+\overline{BE})+(C+\overline{E})(\overline{A}+BD+\overline{E})+\overline{AB}=$$

$$= \overline{ABC} + \overline{BCD} + \overline{BCE} + \overline{CA} + BCD + \overline{CE} + \overline{AE} + BDE + \overline{E} + \overline{AB} =$$

$$\textcircled{+}$$

$$= \overline{AC + CD + \overline{E} + AB} =$$



$$\frac{2}{x} + \frac{1}{4n} = \frac{1}{n}$$

$$\frac{2}{x} = \frac{3}{4n}.$$

$$\frac{x}{2} = \frac{4}{3}n = 0$$
 $x = \frac{8}{3}n = \frac{16}{3}$ = $\frac{16}{3}$ = $\frac{16}{3}$

$$R_{1} = Sool$$

$$R_{2} = Sool$$

$$R_{3} = 2kl$$

$$R_{4} = 2kl$$

$$R_{5} = 4kl$$

$$R_{6} = 4kl$$

$$V_{i} = \frac{1}{3}V_{cc} = 1.6 V$$
 $V_{f} = \frac{V_{cc} R_{S}}{R_{S} + R_{S} || R_{4}} = 4V$

 $V_{OR} = \frac{2}{3}V_{CC} - R_1 I_{RL} = 2.316 V$

7= CRv1 = 1.3 ms

Vix Voon < Vf 1.6V < 2.316V < 4V OK

RV1 = R1 + R3 || R4 || R5 = 1300 D

Tz = Tz ln V: - Vf = 9.974 x10-45

2° FASE) U= \$

D= \$=> VG= VCC VS= \$V => VGS= VCC > V7 => Q1 ON

R3 R3 R3 $R_2 \neq \frac{1}{T}C$

 $\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} & & & \\ & & \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} & & \\ & & \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} & & \\ & & \\ \end{array}$

V; = 2.816 V Ve= 1.6 V

 $V_{TH} = \frac{V_{CC} R_{4}IIR_{5}}{R_{3} + R_{4}IIR_{5}} = 2V$

RTH = R311R411R5 = 800 DZ

Vi>Vcor> VA 2.316V>2V>0.5V

VP = VTH R2 = 0.5 V

 $Z_2 = CRV_2 = 3.61 \times 10^{-4}$

Rv2 = R211[R1+ Roy R311R411R5]=

= R211[R1+ RTH] = 361. 11 R

T2= T2 lu Vi-Ve = 2.7219 x10-4 3

T= T1+T2 = 1.2696 × 10-3

 $f = \frac{1}{T} = 787.63$ Hz